

高解析度微光顯微鏡

High-Resolution Emission Microscope

- 缺陷快速定位
- 節省分析時間
- 為半導體晶片故障分析應用量身定製
- 半導體業內專業級電性定位設備

產品特色

- 可選配兩個超高靈敏度相機
覆蓋範圍包括不同探測波長範圍的微光分析和熱分析，或可見光和近紅外光，允許輕鬆選擇與樣品和故障模式匹配的分析技術
- OBIRCH有多達五種雷射源可供選擇，且相容動態分析技術
- 單一模組適用多種光源（1.3 μm , 1.1 μm , 532nm），支援多種分析

PHAMOS[®]-X

Emission microscope C15765-01



OBIRCH特性

- ✓ 高解析度，高對比度反射模式圖像
- ✓ 可在四個象限測量電壓 / 電流
- ✓ 可進行背面觀測（使用1.3 μm 波長雷射）
- ✓ OBIRCH放大器可以為被測器件施加四個象限電壓 / 電流，軟體可選擇V1模式、I1模式、V2模式和V3模式
- ✓ 由於使用近紅外雷射器，完全避免OBIC信號的影響

EMMI相機特性

- ✓ 近紅外區域的高靈敏度（高量子效率）
- ✓ 分析低工作電壓器件的強大工具，同時可以實現背面分析
- ✓ 可結合雷射顯微鏡，且同時保持高解析度和高靈敏度的分析

電流檢測頭

- ✓ 電流檢測頭可用於測量比標準OBIRCH放大器範圍要求更高電壓（最大3 kv）或更高電流（最大6.3 A）的器件

透鏡選項

- 電動鏡頭轉盤可以搭載5個物鏡

Objective lens

Product Name	Product Number	N.A.	WD (mm)	Analysis
Objective lens 1x for OBIRCH	A7649-01	0.03	20	OBIRCH
Objective lens 2x IR coat	A8009	0.055	34	Emission / OBIRCH
Objective lens NIR 5x	A11315-01	0.14	37.5	Emission / OBIRCH
Objective lens NIR 20x	A11315-03	0.4	20	Emission / OBIRCH
Objective lens PEIR Plan Apo 20x 2000	A11315-21	0.6	10	Emission / OBIRCH
Objective lens PEIR Plan Apo 50x 2000	A11315-22	0.7	10	Emission / OBIRCH
High NA objective lens 50x for IR-OBIRCH	A8018	0.76	12	OBIRCH
Objective lens NIR 100x	A11315-05	0.5	12	Emission / OBIRCH
Objective lens MWIR 0.8x	A10159-02	0.13	22	Thermal emission
Objective lens MWIR 4x	A10159-03	0.52	25	Thermal emission
Objective lens MWIR 8x	A10159-06	0.75	15	Thermal emission

Macro lens

Product Name	Product Number	N.A.	WD (mm)	Analysis
Macro lens 1.35x for PHEMOS®-X	A7909-16	0.4	25	Emission / OBIRCH
Macro lens 0.24x for InSb camera	A10159-08	0.08	27	Thermal emission
Macro lens 1x for InSb camera	A10159-10	0.33	52	Thermal emission

Contact us

新竹市東區水源街95號
+886 3 573 8099 #1078
marketing@spirox.com

